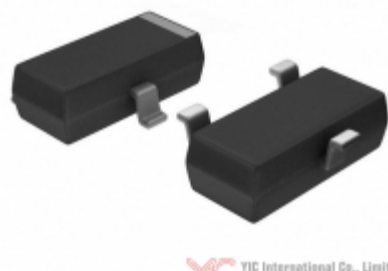
	<h2 style="color: red;">FDN361AN</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDN361AN</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 1.8A SSOT-3</p> <p>Datenblätter: 1.FDN361AN.pdf 2.FDN361AN.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 131939 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN361AN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 1.8A SSOT-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	131939 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 1.8A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 1.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDN361AN ist neu im Original, Suche FDN361AN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN361AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN361AN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN360P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2A SSOT3</p>	 <p>FDN360P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2A SSOT3</p>	 <p>FDN361AN_NL Fairchild FDN361AN_NL Fairchild</p>	 <p>FDN361BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.4A SSOT3</p>
 <p>FDN360 HAM FDN360 HAM</p>	 <p>FDN361BN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.4A SSOT3</p>	 <p>FDN361AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A SSOT-3</p>	 <p>FDN361AN-NL FAIRCHILD FDN361AN-NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDN339N-NL	↔ FDN340P-NL	⇒ FDN342P-NL	D FDN352AP	⇒ FDN352AP
⊕ FDN352AP-NL	⊗ FDN352P-NL	D FDN355A-NL	⇒ FDN355N-NL	⇒ FDN356AP-NL
⊗ FDN356P-NL	⊕ FDN357N-NL	⊗ FDN357NNL	↔ FDN357P-NL	⇒ FDN358P-NL
D FDN359AN	⊗ FDN359AN	⊕ FDN359AN-NL	⊗ FDN359BN	⇒ FDN359BN
⇒ FDN359BN	↔ FDN359BN-NL	⊗ FDN359N-NL	⊕ FDN360P-NL	⇒ FDN360P-NL/360
↔ FDN361AN	⇒ FDN361AN-NL	D FDN361BN	⊗ FDN361BN	⊕ FDN361BN-NL
⊗ FDN362AN-NL	D FDN363N-NL	⇒ FDN371N-NL	↔ FDN372S-NL	⇒ FDN5330SX
⊕ FDN537N-NL	⊗ FDN5618P	↔ FDN5618P	⇒ FDN5618P-NL	⇒ FDN5630-NL
⊗ FDN5630N-NL	⊕ FDN5630_NL	⊗ FDN5632-NL	D FDN5632N	⇒ FDN5632N-F085
↔ FDN5632N-F085	⊗ FDN5632N_F085	⊕ FDN655BN	⊗ FDN8601-NL	⇒ FDN8601N-NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited